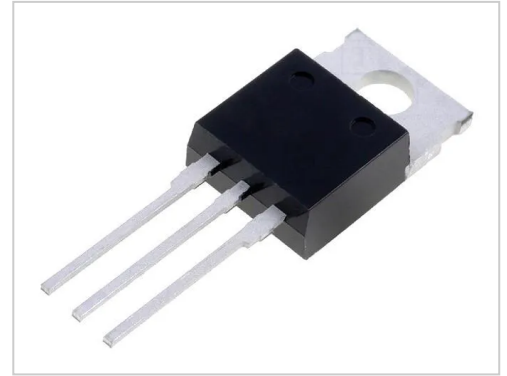


INFINEON MOSFET, 40V Drain-Source, 162A Drainstrom, 200W Verlustleistung, 4 Ohm Widerstand, THT



INFINEON IRF1404PBFIN: Hochleistungs-MOSFET Mit einer Drain-Source Spannung von 40V und einem Drainstrom von 162A bis... Tutto per i vostri progetti di bricolage.

Artikelnummer IRF1404PBF

Gewicht 0.002kg

Produktbeschreibung

INFINEON IRF1404PBFIN: Hochleistungs-MOSFET

Mit einer Drain-Source Spannung von 40V und einem Drainstrom von 162A bietet der INFINEON IRF1404PBFIN enorme Leistung für Motorsteuerungen oder Energieversorgungen. Dank unipolarer Polarisierung und nur 4mΩ Widerstand im Leitungszustand profitierst du von maximaler Effizienz und minimierten Verlusten. Ideal für Maker, die innovative und leistungsfähige Elektronikprojekte realisieren möchten.

Merkmale im Überblick

- Unipolare Polarisierung: Sorgt für eine hohe Effizienz in verschiedenen Schaltungskonfigurationen.
- Widerstand im Leitungszustand von nur 4mΩ: Minimiert Verluste und verbessert die Gesamteffizienz.
- Gate-Ladung von 160nC: Optimiert das Schaltverhalten für schnelle Schaltvorgänge.

Technische Daten

- Drain-Source Spannung: 40V
- Drainstrom: 162A
- Verlustleistung: 200W
- Gehäuse: TO220AB
- Gate-Source Spannung: $\pm 20V$
- Widerstand im Leitungszustand: 4mΩ
- Gate-Ladung: 160nC
- Montage: THT
- Polarisierung: unipolar

Lieferumfang

- 1x Transistor: N-MOSFET, unipolar, 40V, 162A, 200W, TO220AB

Produkteigenschaften

Gewicht Brutto (in kg)	0.002
Zolltarifnummer	85444995
Herkunftsland	China
VPE	1 / 50
Montage	THT
Hersteller	INFINEON TECHNOLOGIES
Artikelnummer	IRF1404PBF
Hersteller Produktnummer	IRF1404PBF

Weitere Bilder

